



20V N-Channel Enhancement-Mode MOSFET

RDS(ON), Vgs@2.5V, Ids@3.0A = 28mΩ

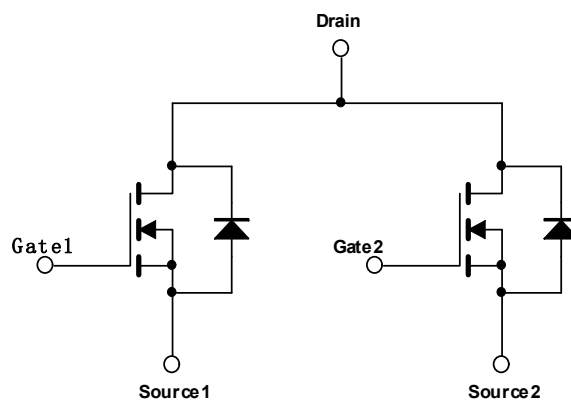
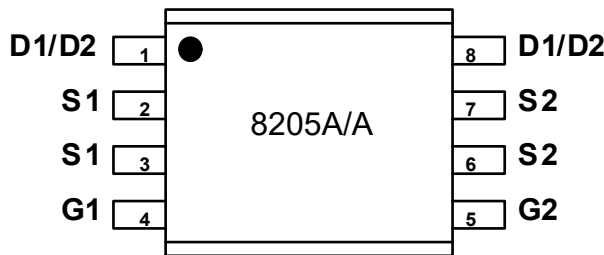
RDS(ON), Vgs@4.0V, Ids@4.0A = 24mΩ

RDS(ON), Vgs@4.5V, Ids@4.5A = 21mΩ

特点

- 专有的先进平面技术
- 高密度超低电阻设计
- 大功率、大电流应用
- 理想的锂电池应用
- 封装形式: SOT23-6、TSSOP-8

8205A/TSSOP-8



N-Channel MOSFET



富满微电子集团股份有限公司

FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.

8205A/A (文件编号: S&CIC0706)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

最大额定值和热特性 (Ta = 25°C, 除非另有说明。)

参数		符号	值	单位
漏源电压		V_{DS}	20	V
栅源电压		V_{GS}	± 12	
漏极电流		I_D	6	A
漏极脉冲电流		I_{DM}	20	
最大功耗	TA = 25°C	P_D	1.9	W
	TA = 75°C		1.25	
工作结温和存储温度范围		T_J, T_{stg}	-55 to 150	°C
结环热阻 (PCB 安装)		$R_{\theta JA}$	62.8	°C/W

注: 重复性极限值: 脉冲宽度由最高结温限制。

贴片时回流焊炉温请控制在 265°C 以下。

电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
静电						
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	20	--	--	V
		$V_{GS} = 2.5V, I_D = 3.5A$	--	28.0	32.0	
		$V_{GS} = 4.0V, I_D = 4.5A$		24.0	30.0	
		$V_{GS} = 4.5V, I_D = 4.5A$		21.0	26.0	
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	0.5	--	1.5	V
栅源短路时漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS} = 20V, V_{GS} = 0V$	--	--	1	μA
漏极短路时截止栅电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 12V, I_D = 0\mu A$	--	--	± 100	nA
跨导	g_{fs}	$V_{DS} = 15V, I_D = 6.0A$	--	25	--	S
动态						
总栅极电荷	Q_g	$V_{DS} = 10V, I_D = 6A$		6.32	8.18	nC



富满微电子集团股份有限公司

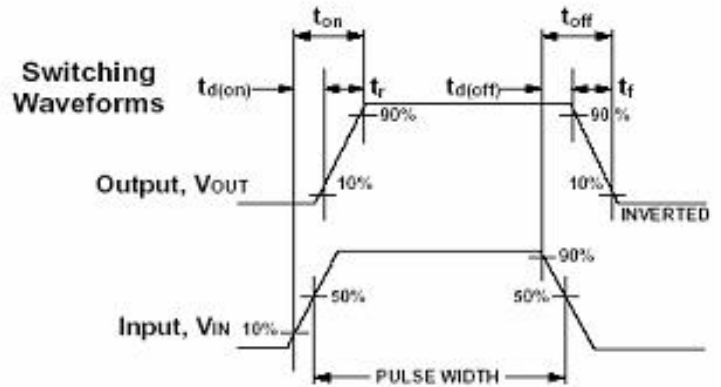
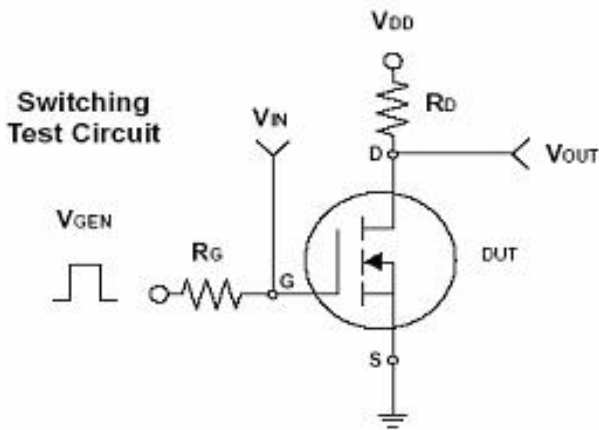
FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.

8205A/A (文件编号: S&CIC0706)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

栅源电荷	Q_{gs}	$V_{GS} = 4.5V$		1.65	2.17	
栅漏电荷	Q_{gd}			1.41	1.76	
延迟时间 (On)	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 10V, I_D = 6A$ $I_D = 1A, V_{GS} = 4.5V$		10.5	21.2	ns
上升时间 (On)	t_r			4.41	8.82	
延迟时间 (Off)	$t_{d(off)}$			27.42	54.84	
下降时间 (Off)	t_f			4.43	8.86	
输入电容	C_{iss}	$V_{DS} = 8V, V_{GS} = 0V$ $f = 1.0MHz$	--	542.8	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	99.87	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	76.53	--	
漏源二极管						
二极管最大正向电流	I_S	--	--	--	1.6	A
二极管正向电压	V_{SD}	$I_S = 1.7A, V_{GS} = 0V$	--	--	1.2	V

注：脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$





富满微电子集团股份有限公司

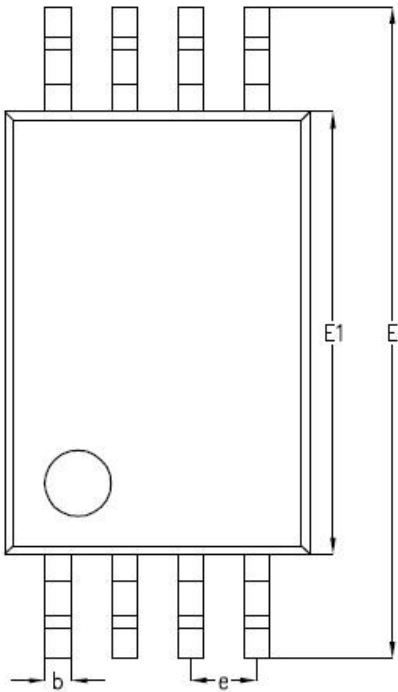
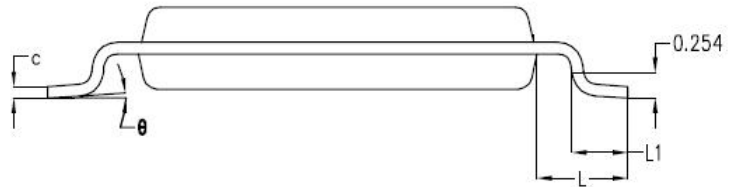
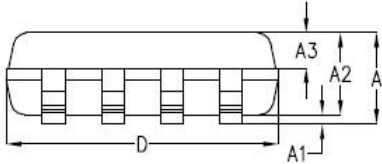
FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.

8205A/A (文件编号: S&CIC0706)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

封装信息

TSSOP-8



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	1.00	1.10
A1	-	0.10	0.15
A2	0.85	0.90	0.95
A3	0.35	0.38	0.41
b	0.20	0.25	0.30
c	0.08	0.13	0.18
D	2.95	3.00	3.05
E	6.30	6.40	6.50
E1	4.35	4.40	4.45
e	0.65BSC		
L	0.95	1.00	1.05
L1	0.60BSC		
θ	0°	4°	8°

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Fuman](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[IRFD120](#) [JANTX2N5237](#) [BUK455-60A/B](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [NDP4060](#) [SI4482DY](#) [IPS70R2K0CEAKMA1](#) [SQD23N06-31L-GE3](#)
[TK16J60W,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [DMN1053UCP4-7](#) [SQJ469EP-T1-GE3](#) [NTE2384](#) [DMC2700UDMQ-7](#)
[DMN2080UCB4-7](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#)
[STF5N65M6](#) [IRF40H233XTMA1](#) [STU5N65M6](#) [DMN6022SSD-13](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [DMN2990UFB-7B](#)
[IPB80P04P405ATMA2](#) [2N7002W-G](#) [MCAC30N06Y-TP](#) [MCQ7328-TP](#) [BXP7N65D](#) [BXP4N65F](#) [AOL1454G](#) [WMJ80N60C4](#) [BXP2N20L](#)
[BXP2N65D](#) [BXT1150N10J](#) [BXT1700P06M](#) [TSM60NB380CP](#) [ROG](#) [RQ7L055BGTCR](#) [DMNH15H110SK3-13](#) [SLF10N65ABV2](#)
[BSO203SP](#) [BSO211P](#) [IPA60R230P6](#) [IPA60R460CE](#)